

深圳市晶盟电子科技有限公司
Shen zhen jing au electronic technolodg to LTD

产品规格说明书

JM-0620HR

高品质 LED 芯片制造商

Leading LED Chip Manufacturer in China

公司：深圳市晶盟电子科技有限公司
地址：广东省深圳市宝安区西乡三围社区索佳科技园索佳综合楼A902
电话：0755-23200023
传真：0755-29593377
网址：[www. uni led. com. cn](http://www.uni led. com. cn)

Red LED Chip For Display

JM-0620HR

1. 产品描述

1.1 产品特征及应用 FEATURE AND APPLICATION

免打线, 系统性成本节约

Wire-bond free, system cost reduction

良好的耐电流冲击能力

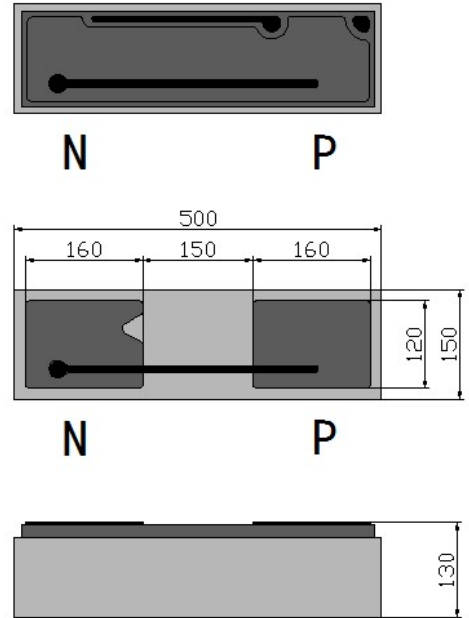
Good Current Impingement Handling Capability

一致性好, 可靠性高

Excellent Uniformity, Good Reliability

应用市场/Application Market	显示屏
封装形式/ PKG Type	COB
驱动电流/Driving Current	10mA
电压/Vf	1.9-2.1V

Unit: μm



1.2 外形尺寸 Outline Dimensions

尺寸: 长×宽/Chip Size	$(500 \pm 25) \times (150 \pm 25) \mu\text{m}^2$
芯片厚度/ Chip thickness	$(130 \pm 15) \mu\text{m}$
P 电极/P bonding pad	$(160 \pm 10) \times (120 \pm 10) \mu\text{m}^2$
N 电极/N bonding pad	$(160 \pm 10) \times (120 \pm 10) \mu\text{m}^2$

1.3 材料和结构 Material and Structure

衬底材料/ Substrate	蓝宝石 Sapphire
外延结构/Epitaxy structure	AlGaInP
P 电极 (阳极) /P electrode(anode)	Au
N 电极 (阴极) /N electrode(cathode)	Au

2. 最大绝对额定值 (封装后) Absolute Maximum Rating(After Package)

参数/ Parameter	符号/ Symbol	条件/ Condition	值/ Range	单位/Unit
正向峰值电流 (1/10 占空比@1KHz) Ta=23°C	If	1/10 占空比 @1KHz	≤40	mA
最大额定电流/Maximum Rated Current	If	Ta=23°C	≤20	mA
存储温度 (仅芯片) / Storage Temperature(only chip)	Tstc	chip	-40 ~ +85	°C
结温/ Junction Temperature	Tj	----	≤110	°C

说明 Note

- ◇ 最大额定电流为单颗芯片在铝基板或铜基板等金属基板固晶使用，且保证 LED 芯片不被破坏下方可使用 (Tj ≤ 110°C)；一般封装后长时间使用电流不超过最大额定电流的 90%。

The maximum rated current is used when the chip is die-attached on the Al, Cu or other metal PCB, and it is guaranteed not to damage the LED (Tj ≤ 110°C). After packaging, the long duration current cannot exceed 90% of the maximum rated current.
- ◇ 本产品可在正向电流及正向电压下使用，不适合在逆向电压下使用。

This product is used under the forward current and forward voltage condition, inappropriate under the reverse voltage condition.
- ◇ 芯片在蓝膜上保存时，蓝膜的保存温度最佳为 5 ~ 35°C。

When the chip is preserved on the blue tape, the preferred temperature of the blue tape is 5 ~ 35°C.

3. 光电性能特性 Optical and Electrical Characteristics(Ta=23°C)

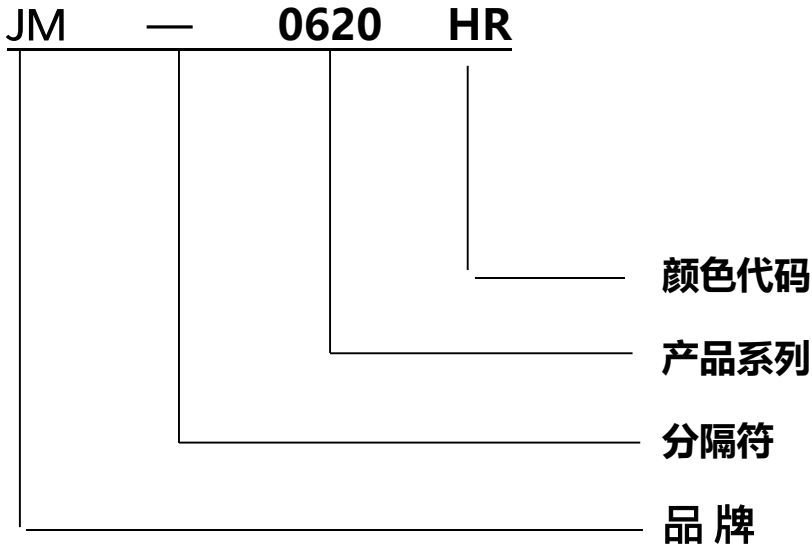
参数 Parameter	料号 (Code)	工作条件 Test Condition	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
发光强度 Luminous Intensity	LR17	@10mA	700	800	mcd
	L632		800	900	
	L633		900	1000	
	L634		1000	1100	
主波长 Dominant Wavelength	W36	@10mA	620	625	nm
正向电压 Forward Voltage	C	@10mA	1.9	2.0	V
	D		2.0	2.1	
防静电 Anti-static	-	HBM	-2	-	KV
反向电流 Reverse Current	-	@-25V	-	1.0	μA
反向电压 Reverse Voltage	-	@-10μA	30	-	V
开启电压 Cut-in voltage	-	@0.1μA	1.3	1.6	V

说明 Note

- ◇ 所有数据均是基于测试仪器上实施的裸晶芯片测试，99%的芯片符合标准。All data are based on measurements by HC SemiTek' s equipment on bare chips within 99% of the nominal value.
- ◇ 主波长的测试误差为±0.5nm。Measurement error for dominant wavelength is ±0.5nm.
- ◇ 发光强度的测试误差为±5%。Measurement error for luminous intensity is ±5%.
- ◇ 正向电压的测试误差为±0.05V。Measurement error for forward voltage is ±0.05V.

产品命名规范

市场产品命名说明



规格

W36 L632 C — 33

